

PIN 二极管主要电特性参数 (T_A=25℃)

参数名称	击穿电压	正向微分电阻	总电容	反向电流	瞬态热阻	载流子寿命	反向恢复时间	串联电阻	正向压降	封装类型
符 号	V _(BR)	r _F	C _{tot}	I _R	R _{th}	τ	t _{rr}	R _s	V _F	—
测试条件	I _R =10μA	I _F =100mA f=50Hz	V _R =30V, f=1MHz	V _R =200V	I _F =100mA t _w =1s	I _F =10mA	I _F =10mA I _R =100mA	I _F =100mA f=100MHz	I _F =10mA	—
单 位	V	Ω	pF	μA	℃/W	ns	ns	Ω	V	—
极限值 型号	最小	最大	最大	最大	最大	最小	最大	最大	最大	—
WP0002A	—	1.42@30mA	0.27	1@260V	150	450 _(typ)	90	1.3@30V _(typ)	—	T1210
WP0002B	—	1.38@30mA	0.27	1@230V	150	450 _(typ)	90	1.3@30V _(typ)	—	
WP0003	—	2.2@20mA	0.20	1@50V	200	70 _(typ)	20	1.6@30V _(typ)	—	
WP47A	—	1.5@30mA	0.30	1@220V	100@10s _(typ)	200 _(typ)	80	1.2@10mA _(typ)	—	
WP47B	—	1.5@30mA	0.30	1@280V	100@10s _(typ)	200 _(typ)	80	1.2@10mA _(typ)	—	
WP49	—	2.1@30mA	0.20	1@100V	134@10s _(typ)	200 _(typ)	65@1/10mA _(typ)	3.9@10mA _(typ)	—	
WP0007	—	0.7	(0.8~1.2) _{@50V}	1@400V	30@ _(0.5A, 10ms)	—	—	—	—	JW02F002
WP0008H	—	1.0	(0.3~0.6) _{@40V}	1@800V	30@ _(0.5A, 10ms)	6000 _(typ)	—	—	—	芯片
WP0009H	—	0.7	(0.20~0.35) _{@38V}	1@800V	15@ _(0.5A, 10ms)	5000 _(typ)	—	—	—	
WP0010H	—	1.0@50mA	0.8@10V	1@50V	—	—	20	—	—	W122
WP0011A	—	—	2.8@100V	1@2000V	6@ _(0.5A, 10ms)	10000	—	0.4@ _{0.5A, 4MHz}	1.2@1A	T631
WP0011B	—	—	2.8@100V	1@2000V	6@ _(0.5A, 10ms)	10000	—	0.4@ _{0.5A, 4MHz}	1.2@1A	T100-1
WP0011C	—	—	3.2@100V	1@2000V	3@ _(0.5A, 10ms)	10000	—	0.2@ _{0.5A, 4MHz}	1.2@1A	T631
WP0011D	—	—	3.2@100V	1@2000V	3@ _(0.5A, 10ms)	10000	—	0.2@ _{0.5A, 4MHz}	1.2@1A	T633
WP0011E	—	—	3.2@100V	1@2000V	3@ _(0.5A, 10ms)	10000	—	0.2@ _{0.5A, 4MHz}	1.2@1A	T632
WP0011F	—	—	3.2@100V	1@2000V	3@ _(0.5A, 10ms)	10000	—	0.2@ _{0.5A, 4MHz}	1.2@1A	H632
WP0011G	—	—	3.2@100V	1@2000V	3@ _(0.5A, 10ms)	10000	—	0.2@ _{0.5A, 4MHz}	1.2@1A	H631
WP0012A	—	—	4.0@100V	1@3000V	2@ _(0.5A, 10ms)	20000	—	0.25@ _{0.5A, 4MHz}	1.2@1A	T100-1
WP0012B	—	—	4.0@100V	1@3000V	2@ _(0.5A, 10ms)	20000	—	0.25@ _{0.5A, 4MHz}	1.2@1A	T100-3
WP0012C	—	—	4.0@100V	1@3000V	2@ _(0.5A, 10ms)	20000	—	0.25@ _{0.5A, 4MHz}	1.2@1A	T100-2
WP0012D	—	—	4.0@100V	1@3000V	2@ _(0.5A, 10ms)	20000	—	0.25@ _{0.5A, 4MHz}	1.2@1A	H100-2
WP0012E	—	—	4.0@100V	1@3000V	2@ _(0.5A, 10ms)	20000	—	0.25@ _{0.5A, 4MHz}	1.2@1A	H100-1
WP0013H	—	1.0	0.40@40V	1	200@10ms	—	400	—	1.0	W121
WP0014H	—	0.85	—	1	—	—	—	—	1.0	SOD-323
WP014	—	2.5	0.08@50V	1@50V	—	—	50 _(typ)	—	—	芯片
WP0001HA	35	1.0	1.0@20V	—	—	100 _(typ)	10 _(typ)	0.6 _(typ)	—	SOT-23 (P1A)
WP0001HB	35	1.0	1.0@20V	—	—	100 _(typ)	10 _(typ)	0.6 _(typ)	—	SOT-23 (P1B)
WP0001HC	35	1.0	1.0@20V	—	—	100 _(typ)	10 _(typ)	0.6 _(typ)	—	SOT-23 (P1C)
WP0001HD	35	1.0	1.0@20V	—	—	100 _(typ)	10 _(typ)	0.6 _(typ)	—	SOT-23 (P1D)
WP0001HE	35	1.0	1.0@20V	—	—	100 _(typ)	10 _(typ)	0.6 _(typ)	—	SOT-23 (P1E)
WP321	—	1.5@50mA	0.22	1@50V	—	—	30	2@200MHz _(typ)	—	W304
WP322	—	1.5@50mA	0.22~0.29	1@50V	—	—	30	2@200MHz _(typ)	—	

PIN 二极管主要电特性参数 (续上表):

参数名称	击穿电压	正向微分电阻	总电容	反向电流	瞬态热阻	载流子寿命	反向恢复时间	串联电阻	正向压降	封装类型
符 号	$V_{(BR)}$	r_F	C_{tot}	I_R	R_{th}	τ	t_{rr}	R_s	V_F	—
测试条件	$I_R=10\mu A$	$I_F=100mA$ $f=50Hz$	$V_R=30V, f=1MHz$	$V_R=200V$	$I_F=100mA$ $t_w=1s$	$I_F=10mA$	$I_F=10mA$ $I_R=100mA$	$I_F=100mA$ $f=100MHz$	$I_F=10mA$	—
单 位	V	Ω	pF	μA	$^{\circ}C/W$	ns	ns	Ω	V	—
极限值 型号	最小	最大	最大	最大	最大	最小	最大	最大	最大	—
WP323	—	1.5@50mA	0.29~0.40	1@50V	—	—	30	2@200MHz (typ)	—	W304
WP324	—	1.2@50mA	0.40~0.50	1@50V	—	—	30	2@200MHz (typ)	—	
WP325	—	1.2@50mA	0.50~0.60	1@50V	—	—	30	2@200MHz (typ)	—	
(G)WP322	—	1.5@50mA	0.45	1@50V	—	—	30	—	1.0	W202
WP32X	—	1.5@50mA	0.50	1@50V	—	—	30	2@50mA (typ)	—	芯片
WP341	—	1.0	(0.23~0.50)@50V	1@50V	200@10ms	—	200	—	1.0	T182
WP342	—	1.0	(0.23~0.50)@50V	1@300V	200@10ms	—	200	—	1.0	
WP351	—	2.0	(0.04~0.1)@50V	1@50V	—	—	—	—	—	Q4(芯片)
WP352	—	2.0	(0.04~0.1)@50V	1@300V	—	—	—	—	—	
WP361	—	3.0	(0.02~0.05)@50V	1@100V	—	—	—	—	—	Q3(芯片)
WP362	—	3.0	(0.05~0.07)@50V	1@100V	—	—	—	—	—	
WP3861	—	1.5	0.25@0V	1@50V	300@(0.5A, 10ms)	—	20@20/200mA	—	—	W202
WP3862	—	1.5	(0.26~0.30)@0V	1@50V	300@(0.5A, 10ms)	—	20@20/200mA	—	—	
WP3863	—	1.5	(0.31~0.40)@0V	1@50V	300@(0.5A, 10ms)	—	20@20/200mA	—	—	

限幅二极管主要电特性参数 (T_A=25℃)

参数名称	击穿电压	正向微分电阻	结电容	反向电流	瞬态热阻	载流子寿命	反向恢复时间	串联电阻	正向压降	封装类型
符 号	V _(BR)	r _F	C _j	I _R	R _{th}	τ	t _{rr}	R _s	V _F	—
测试条件	I _R =10μA	I _F =100mA f=50Hz	V _R =30V, f=1MHz	V _R =200V	I _F =100mA t _w =1s	I _F =10mA	I _F =10mA I _R =100mA	I _F =100mA f=100MHz	I _F =10mA	—
单 位	V	Ω	pF	μA	℃/W	ns	ns	Ω	V	—
极限值 型号	最小	最大	最大	最大	最大	最小	最大	最大	最大	—
WI0001HA	20	1.5	0.08~0.20	—	—	—	—	—	—	芯片
WI0001HB	28	1.5	0.08~0.15	—	—	—	—	—	—	
WI0002	—	0.5	3.0 _{@0V} /2.4 _{@6V}	1 _{@40V}	30 _{@(0.5A, 10ms)}	—	—	—	—	C406
WI0003	—	2.0 _{@50mA}	0.15 _{@0V}	1 _{@50V}	—	—	—	—	—	芯片
WI0004F	—	0.6	0.8 _{@0V}	1 _{@120V}	80	—	60	—	—	W122
WI0005F	15	1.2	0.30 _{@0V}	—	120 _(0.5A, 10ms)	—	15 _{@6/10mA}	—	—	
WI0006F	30	1.2	0.30 _{@0V}	—	100 _(0.5A, 10ms)	—	5 _{@6/10mA (typ)}	—	—	
WI0004	—	0.6	0.80 _{@0V}	1 _{@120V}	80	—	—	—	—	芯片
WI0005	15	1.2	0.30 _{@0V}	—	120 _(0.5A, 10ms)	—	—	—	—	
WI0006	30	1.2	0.30 _{@0V}	—	100 _(0.5A, 10ms)	—	—	—	—	
WI0007H	—	0.6	C _t : (1.5~2.2) _{@0V}	1 _{@120V}	—	—	—	—	—	T209
WI0009H	20~25	1.2	C _t : 0.4 _{@0V}	—	150 _(0.5A, 10ms)	—	—	—	—	
WI0010H	20~35	1.0	0.35 _{@0V}	—	150 _{@(0.5A, 10ms)}	—	—	—	—	
WI0011	—	0.7	C _t : 1.0 _{@0V}	1 _{@50V}	100 _{@(0.5A, 10ms)}	—	—	0.60 _{@10mA}	—	W121
WI0012H	25~40	2.5	0.20 _{@0V}	—	—	15	—	—	—	T209
WI0013H	—	0.50	1.0 _{@0V}	1 _{@100V}	—	—	—	—	—	芯片
WI3211	20	1.0	(0.15~0.20) _{@0V}	—	100 _{@10ms}	—	—	—	—	T124
WI3212	20	1.0	(0.20~0.25) _{@0V}	—	100 _{@10ms}	—	—	—	—	
WI3213	20	1.0	(0.25~0.30) _{@0V}	—	100 _{@10ms}	—	—	—	—	
WI3221	30	1.0	(0.15~0.20) _{@0V}	—	100 _{@10ms}	—	—	—	—	
WI3222	30	1.0	(0.20~0.25) _{@0V}	—	100 _{@10ms}	—	—	—	—	
WI3223	30	1.0	(0.25~0.30) _{@0V}	—	100 _{@10ms}	—	—	—	—	
WI3311	35	0.65	(0.45~0.75) _{@0V}	—	60 _{@(0.5A, 10ms)}	—	—	—	—	T204(正装)
WI3312	35	0.65	(0.45~0.75) _{@0V}	—	60 _{@(0.5A, 10ms)}	—	—	—	—	T204(反装)
WI3321	40	0.65	(0.55~0.65) _{@0V}	—	30 _{@(0.5A, 10ms)}	—	—	—	—	T204(正装)
WI3322	40	0.65	(0.55~0.65) _{@0V}	—	30 _{@(0.5A, 10ms)}	—	—	—	—	T204(反装)
WI341	35	1.0	(0.4~0.7) _{@0V}	—	150 _{@(0.5A, 10ms)}	—	—	—	—	W202
WI342	40	0.6	(0.5~0.6) _{@0V}	—	150 _{@(0.5A, 10ms)}	—	—	—	—	
WI371	30	1.5	(0.10~0.15) _{@0V}	—	200 _{@10ms}	—	—	—	—	T124
WI372	25	1.5	(0.15~0.25) _{@0V}	—	200 _{@10ms}	—	—	—	—	

开关二极管主要电特性参数 (T_A=25℃)

参数名称	击穿电压	正向微分电阻	总电容	反向电流	瞬态热阻	载流子寿命	反向恢复时间	串联电阻	正向压降	封装类型
符 号	V _(BR)	r _F	C _{tot}	I _R	R _{th}	τ	t _{rr}	R _s	V _F	—
测试条件	I _R =10μA	I _F =100mA f=50Hz	V _R =30V, f=1MHz	V _R =200V	I _F =100mA t _w =1s	I _F =10mA	I _F =10mA I _R =100mA	I _F =100mA f=100MHz	I _F =10mA	—
单 位	V	Ω	pF	μA	℃/W	ns	ns	Ω	V	—
极限值 型号	最小	最大	最大	最大	最大	最小	最大	最大	最大	—
WK0001H	—	3.5@20mA	0.45@50V	1@150V	300@10s (typ)	—	—	—	1.05@100mA	D0-35
WK0002A	—	2.6@20mA	0.10@0V/0.07@(-6V)	1@80V	75@(0.5A, 10ms)	120	—	—	—	W121
WK0002B	—	2.6@20mA	0.10@0V/0.07@(-6V)	1@80V	75@(0.5A, 10ms)	120	—	—	—	W122
WK0003	—	1.0	0.60@50V	1@100V	—	—	350	—	—	芯片
WK0004	—	1.2	0.05@50V	1@100V	—	130	—	—	—	
WK31 ^a	—	4.5@20mA	0.05~0.10	1@80V	—	—	20@20/200mA	—	—	B341
WK314 ^a	—	5.0@20mA	0.10	1@50V	—	—	8@20/200mA	—	—	
WK351	50	1.0	0.25@(-6V)	—	—	—	20@20/200mA	—	—	W121
WK352	50	1.0	0.30@(-6V)	—	—	—	20@20/200mA	—	—	
WK361	—	0.6	3.5@50V	1@300V	55@1A	82000	—	0.35 (typ)	0.95@100mA	D0-41
WK362	—	1.0	4.0@50V	1@300V	55@1A	82000	—	0.35 (typ)	1.05@100mA	
WK39H	—	2.5@20mA	1.2@50V	1@150V	116@10s (typ)	—	—	0.58 (typ)	1.0@100mA	D0-35
WK4153H	—	—	2.5@0V	1@50V	—	—	8@10/10mA	—	0.55@0.1mA	

注: ^a WK31、WK314 插损、隔离度见分类表。

参数名称	隔离度	插损	隔离度	插损
符 号	ISO	IL	ISO	IL
测试条件	f=(16.0~16.5)GHz V _R =12V	f=(16.0~16.5)GHz I _F =15mA	f=(16.5~17.0)GHz V _R =12V	f=(16.5~17.0)GHz I _F =15mA
单 位	dB	dB	dB	dB
极限值 型号	最小	最大	最大	最大
WK311A	10	1.5	—	—
WK311B	—	—	10	1.5
WK312A	20	1.0	—	—
WK312B	—	—	20	1.0
WK313A	25	0.75	—	—
WK313B	—	—	25	0.75

参数名称	隔离度	插损
符 号	ISO	IL
测试条件	f=(15.9~16.1)GHz V _R =5V	f=(15.9~16.1)GHz I _F =10mA
单 位	dB	dB
极限值 型号	最小	最大
WK314A	23	1
WK314B	15	1